

연구개발협약서



연구협약내용

■ 연구개발과제명

국문 : ALD 장비를 이용한 고유전상수를 갖는 thin gate dielectric 박막 증착 기술 개발

영문 : Development of high-k gate dielectric thin film deposition technology using ALD system

■ 총 연구개발기간 : 2001년 3월 1일 ~ 2002년 2월 28일(총 1년)

■ 협약연구개발기간 : 2001년 3월 1일 ~ 2002년 2월 28일

■ 기술개발 지원금 : 총 33,000천원

IPS : 10,000천원(현금 : 10,000천원)

반도체제조장비국산화연구센터 : 23,000천원

■ 연구책임자 : 호서대학교 김좌연 교수

■ 협약당사자

(갑) IPS : 대표이사 이용한

(을) 반도체 제조장비 국산화 연구센터 : 소장 황희음

#별첨 : 연구계획서 1부

상기 연구에 관하여 “갑”과 “을”은 다음과 같이 협약을 체결한다.

제 1조 (연구개발목표)

본 연구의 목표는 별첨 연구 계획서의 연구개발 목표와 같다.

제 2조 (연구개발의 수행)

“을”은 연구책임자에게 본 연구개발 사업을 연구 계획서의 일정에 따라 수행하도록 한다.

제 3조 (연구개발비의 지급)

1. “갑”은 “을”에게 연구개발비를 연구개시 후 1개월 이내에 50%, 중간보고서 제출 후 1개월 이내에 나머지 50%를 지급한다.

금 10,000천원(현금 : 10,000천원)

단, 상기 연구개발 사업의 예산 및 자금사정과 본 협약서 제 9조에 따라 협약이 해제되었을 경우에는 변경할 수 있다.

2. “을”은 지급 받은 연구개발비를 당 사업의 목적에 맞도록 사용하여야 한다.

제 4조 (연구개발 결과 보고서)

“을”은 중간보고서를 연구개발 개시 6개월 후에, 최종보고서는 연구개발 종료 후 1개월 이내에 갑에게 제출해야 한다.

제 5조 (비밀 보장)

1. “갑”과 “을”은 상대방의 승인 없이는 본 연구와 관련하여 취득한 상대방의 비밀을 외부에 공개할 수 없다.
2. “갑”과 “을”은 본 연구개발 결과를 공개하거나 발표할 경우 반드시 상호간에 사전 협의를 한 후에 해야 한다.

제 6조 (산업 재산권 및 발생품의 귀속)

1. 상기의 연구개발 수행과정에서 발생한 기자재, 연구시설, 현물 투자 분 및 시제품등에 대한 유형적 발생품은 “을”의 소유로 한다. 단, 동 연구개발의 결과로서 산업재산권을 취득하고자 할 경우에는 “갑”과 “을”의 연구 참여자를 공동 발명자로 하고 출원인 또한 “갑”과 “을”을 공동으로 한다.
2. 상기 연구개발로 획득한 산업 재산권의 사용은 “갑”과 “을”로 하며, 제 3자에게(동 산업재산권을 이용하여 “갑”이 제 3자에게 판매하는 장비의 경우는 제외한다.) 대여 또는 이관함으로 인하여 발생하는 수익에 대하여는 “갑”과 “을”의 공동 소유로 한다.

제 7조 (협약의 변경)

“갑”과 “을”은 상호 협의하여 본 협약의 내용과 사업 계획서의 내용을 변경할 수 있다.

제 8조 (협약의 해제)

1. “갑”과 “을”은 상대방이 본 협약을 중대하게 위반하였을 경우 각각 본 협약을 해약할 수 있다.
2. “갑”은 다음 사유가 발생하였을 경우 “을”과 협의하여 본 협약을 해약할 수 있다.
(가) 연구개발이 정지상태가 되어 소기의 성과를 기대하기 곤란하거나 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우

- (나) 추구하는 연구개발 목표가 다른 연구 개발에 의해 성취되어 상기 연구 개발 사업을 계속할 필요성이 없다고 판단된 경우
- (다) 기타 중대한 사유로 인하여 본 연구개발 사업의 계속 수행이 불가능하거나 불필요하다고 인정되는 경우
3. 본 협약이 해약되었을 경우에는 “을”은 기수령 한 산업체 지원금 중 실제로 본 연구개발에 사용하지 아니한 금액을 “갑”에게 상환 시켜야 한다.

제 9조 (효력 발생)

본 협약의 효력은 2001년 3월 1일부터 발생한다.

2001년 2월 28일

“갑”

주소 : 경기도 평택시 지제동 33번지

IPS

대표이사 : 이 용 한



“을”

주소 : 충남 아산시 배방면 세출리 산29-1

연구기관 : 호서대학교 반도체 제조장비 국산화 연구센터

소장 : 황 희 읍




연구책임자 : 김 좌 연

(인)

소속 : 호서대학교 신소재기계공학부

직위 : 교수

참여 산업체 협약서

기업체명	IPS				
대표자 성명	이 용 한				
연구 과제명	ALD 장비를 이용한 고유전상수를 갖는 thin gate dielectric 박막증착기술 개발				
연구 책임자	성명 : 김좌연 소속 : 호서대학교, 신소재공학과				
지원 내역 (단위:천원)	년도	1차년도 (‘01.3-’02.2)	2차년도 (‘00.3-’00.2)	3차년도 (‘00.3-’00.2)	합계
	현 금	10,000			10,000
	현 물				
	계	10,000			10,000
<p>본 업체에서는 반도체 제조장비 국산화 연구센터의 규정을 준수하며 상기와 같은 지원내역을 협약합니다.</p> <p style="text-align: right;">2000. 2. 26.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 50px;"> <div>IPS(주) 대표이사</div> <div>이 용 한 </div> </div>					